

БКО.348.422-08 ТУ

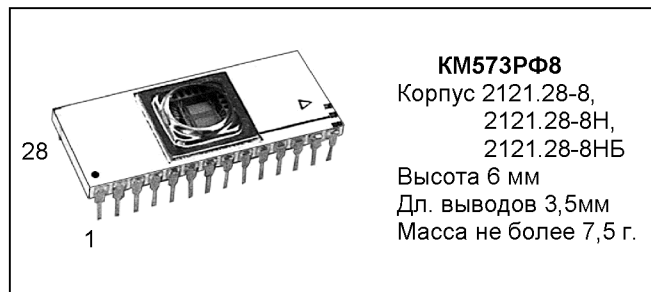
**256К (32Кx8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ С
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ**

NМОП технология

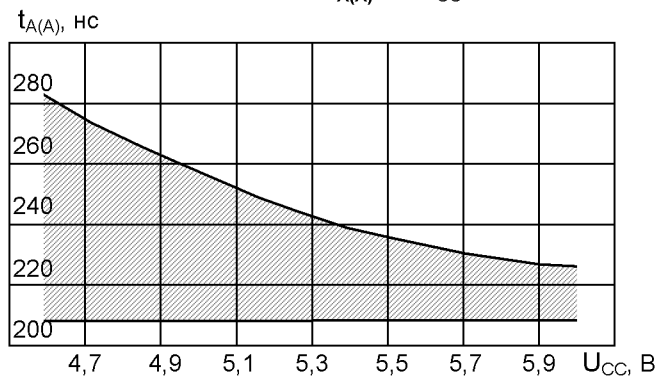
**KM573PФ8A
KM573PФ8Б
KM573PФ8В**

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с УФ-стиранием информации обеспечивает возможность длительного хранения и многократной смены информации. Микросхема функционально аналогична зарубежным микросхемам класса 27256 и может заменять их без изменения разводки печатных плат.

- время выборки адреса 250нс;
- напряжение питания $5В \pm 5\%$;
- напряжение программирования $12,5В \pm 0,5В$;
- допустимое значение статического потенциала не более 100В.

**НАДЕЖНОСТЬ**

Наработка, ч	$t_{и}$	50 000
Интенсивность отказов 1/ч	$\lambda_{и}$	$1 \cdot 10^{-6}$
Приемочный уровень программируемости микросхемы	AQL	2,5
Срок хранения, лет	$t_{хр}$	12

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ $t_{A(A)}$ от U_{CC} **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

1	U_{PR}	Напряжение программирования
2 -10, 21, 23-27	A0-A14	Вход адресный
11-13, 15 -19	D0 -D7	Вход-выход
14	GND	Общий
20	\overline{CE}	Вход сигнала разрешения обращения
22	\overline{OE}	Вход сигнала разрешения выхода
28	U_{CC}	Источник питания

ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ**МЕХАНИЧЕСКИЕ**

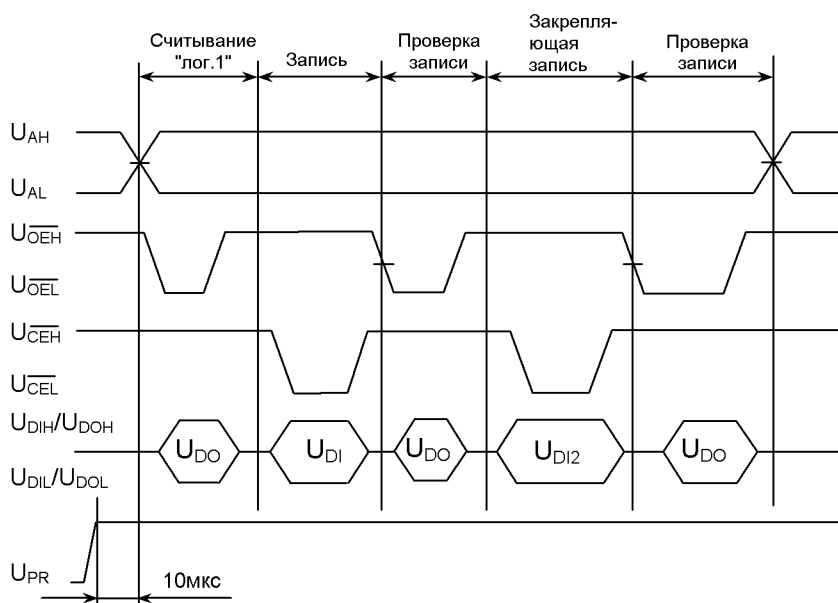
Механические удары, g	150
Линейное ускорение, g	500
Вибрация 1 - 2 000 Гц, g	20
Устойчивость к воде и спиртобензиновой смеси	1:1

КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих температур, °С	от - 45 до 70
Изменение температуры среды, °С	от - 60 до 85
Повышенная влажность при $T = 35$ °С, %	до 98
Температура пайки, °С	235 ± 5
Продолжительность, с	$2 \pm 0,5$

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ($U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 5\%$)

Символ	Параметр	T, °C	KM573PФ8A	KM573PФ8Б	KM573PФ8В
U_{OL}	Выходное напряжение низкого уровня, В ($I_{OL} = 2,1 \text{ mA}$)	от - 45 до 70	$\leq 0,45$	$\leq 0,45$	$\leq 0,45$
U_{OH}	Выходное напряжение высокого уровня, В ($I_{OH} = 0,4 \text{ mA}$)	от - 45 до 70	$\geq 2,4$	$\geq 2,4$	$\geq 2,4$
I_{CCRD}	Ток потребления в режиме считывания, мА	25, 70 - 45	≤ 110 ≤ 125	≤ 110 ≤ 125	≤ 110 ≤ 125
I_{CCS}	Ток потребления в режиме хранения, мА	25, 70 - 45	≤ 45 ≤ 50	≤ 45 ≤ 50	≤ 45 ≤ 50
I_{LI}	Ток утечки по каждому входу, мкА	от - 45 до 70	≤ 8	≤ 8	≤ 8
$I_{L/O}$	Ток утечки на входе/выходе, мкА	от - 45 до 70	≤ 8	≤ 8	≤ 8
$t_{A(AA)}$	Время выборки адреса, мкс	от - 45 до 70	$\leq 0,25$	$\leq 0,30$	$\leq 0,45$
$t_{A(CE)}$	Время выборки разрешения обращения, мкс	от - 45 до 70	$\leq 0,25$	$\leq 0,30$	$\leq 0,45$
$t_{A(OE)}$	Время выборки разрешения выхода, мкс	от - 45 до 70	$\leq 0,10$	$\leq 0,12$	$\leq 0,15$
t_{SG1}	Время хранения информации при отключённом питании, ч	25, - 45 70	$\geq 100\ 000$ $\geq 25\ 000$	$\geq 100\ 000$ $\geq 25\ 000$	$\geq 100\ 000$ $\geq 25\ 000$
t_{SG2}	Время хранения информации при включённом питании, ч	25, - 45 70	$\geq 50\ 000$ $\geq 25\ 000$	$\geq 50\ 000$ $\geq 25\ 000$	$\geq 50\ 000$ $\geq 25\ 000$
C_I	Входная ёмкость выводов микросхем, пФ	25 ± 10	≤ 16	≤ 16	≤ 16
$C_{I/O}$	Ёмкость входа-выхода, пФ	25 ± 10	≤ 16	≤ 16	≤ 16
N_{CY}	Количество циклов перепрограммирования, цикл	25 ± 10	≥ 25	≥ 25	≥ 25

ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ-СЧИТЫВАНИЯ
(verify)


Питание микросхем и схем, формирующих адресные входные и управляющие сигналы, должны подключаться к одному источнику питания.

Выходы микросхем могут находиться в трёх состояниях:

- считывается низкий уровень сигнала;
- считывается высокий уровень сигнала;
- состояние "Выключено" с высоким выходным сопротивлением.

Ток программирования I_{PR} в режиме считывания не более 5,0 мА, а в режиме программирования 30 мА (импульсный);

Время нарастания сигнала U_{PR} при переходе в режим записи, не менее 5 мкс, а на вершине фронта не допускается выброс;

Допускается перепрограммировать микросхему до 100 раз. (Один цикл: запись-стирание).